
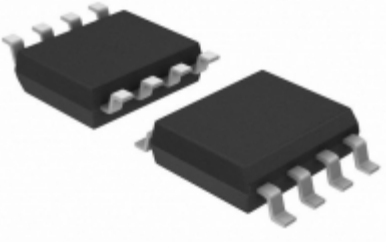
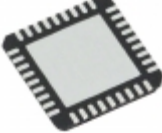


	<p>SI4210DY-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4210DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 6.5A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4210DY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 6800 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4210DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 6.5A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6800 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 6.5A 2.7W
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	2.7W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.5A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35.5 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	445pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SI4210
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI4210DY-T1-GE3-ND

SI4210DY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI4210DY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4210DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4210DY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI4212-RRDA-EVB Energy Micro (Silicon Labs) BOARD EVALUATION FOR SI4212</p>	 <p>SI4210GM NXP SI4210GM NXP</p>	 <p>SI4212-B-GM Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX CELLULAR 36- VFQFN</p>	 <p>SI4210GM. N/A SI4210GM. N/A</p>
 <p>SI4210-T-IF-EVB Energy Micro (Silicon Labs) BOARD RADIO INTRFC FOR SI4210</p>	 <p>SI4210-GM (AERO4210HN/1 SILICON SI4210-GM (AERO4210HN/1 SILICON</p>	 <p>SI4210-X-BO-EVB Energy Micro (Silicon Labs) BOARD BREAKOUT FOR SI4210</p>	 <p>SI4210DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 6.5A 8- SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ SI4190ADY	➡ SI4196DY-T1-GE3	➡ SI4196DY-T1-GE3	D SI4200-BM	➡ SI4200-BMR
⊣ SI4200-GM	⚙ SI4200-GMR	D SI4200BM	➡ SI4200DB-BMR	➡ SI4200DY-T1-E3
⚙ SI4201-BMR	⊣ SI4201-GMR	⚙ SI4202DY	➡ SI4205-BM	➡ SI4205-BMR
D SI4206-BM	⚙ SI4206-BMR	⊣ SI4208-A-GMR	⚙ SI4208GM	➡ SI4209-A-GMR
➡ SI4210-C-GMR	➡ SI4210-D-GMR	⚙ SI4210-GM	⊣ SI4210DY-T1-E3	➡ SI4210DY-T1-GE3
➡ SI4210GM	➡ SI4214DDY	D SI4214DDY-T1-E3	⚙ SI4214DDY-T1-E3	⊣ SI4214DDY-T1-GE3
⚙ SI4214DDY-T1-GE3	D SI4214DY-T1-E3	➡ SI4214DY-T1-GE3	➡ SI4214DY-T1-GE3	➡ SI4220-GM
⊣ SI4226DY	⚙ SI4226DY-T1-E3	➡ SI4226DY-T1-E3	➡ SI4226DY-T1-GE3	➡ SI4226DY-T1-GE3
⚙ SI4228DY	⊣ SI4228DY-T1-E3	⚙ SI4228DY-T1-E3	D SI4228DY-T1-GE3	➡ SI4228DY-T1-GE3
➡ SI4232DY.	⚙ SI4276DY-T1-E3	⊣ SI4276DY-T1-E3	⚙ SI4282DVP	➡ SI4286DY

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited